#### FORMING METHOD OF PATTERN

Publication number: JP2004071473
Publication date: 2004-03-04

Inventor:

KOBAYASHI YOSHIHIRO

Applicant:

DAINIPPON PRINTING CO LTD

Classification:

- international:

G02B5/20; B05D1/38; B05D3/04; B05D3/06; B05D3/10; B05D5/00; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; G02B5/20; B05D1/38; B05D3/04; B05D3/06; B05D3/10; B05D5/00; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; (IPC1-7): H05B33/10;

B05D1/38; B05D3/04; B05D3/06; B05D3/10; B05D5/00;

G02B5/20; H05B33/14

- european:

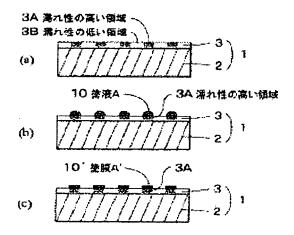
Application number: JP20020231974 20020808 Priority number(s): JP20020231974 20020808

Report a data error here

#### Abstract of JP2004071473

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a uniform pattern in a provided section of a substrate by applying a solution without unevenness and going out of the section and to bring out physical function of the product well according to the variation of materials applied on the substrate.

SOLUTION: A wettability variable layer 3 with variable wettability by receiving energy is deposited on a substrate 2, and a highwettability part 3A is formed by exposing a pattern. A solution for application 10 with a solvent of high polarity is applied to the part and dried to form a dried applied film 10' to solve the problem. Another applied film can be formed on the film 10' using a solution with a solvent having affinity to the film 10'. COPYRIGHT: (C)2004.JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

JP 2004 71473 A 2004.3.4

#### (19) 日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2004-71473 (P2004-71473A)

(43) 公開日 平成16年3月4日 (2004.3.4)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		FI			テーマコー	ド (参考)
HO5B	33/10	но 5 В	33/10		2HO48	
B05D	1/38	BO5D	1/38		3KOO7	
BO5D	3/04	BO5D	3/04	С	4DO75	
BO5D	3/06	BO5D	3/06			
B05D	3/10	BO5D	3/06 1	02		
		審查請求 オ	清末 請求項	頁の数 3 OL	(全 18 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日		特願2002-231974 (P2002-231974) 平成14年8月8日 (2002.8.8)	(71) 出願人	100111659 弁理士 金山	式会社 市谷加賀町一丁 聡	目1番1号
			(72) 発明者	小林 義弘 東京都新宿区	市谷加賀町一丁	目1番1号

最終頁に続く

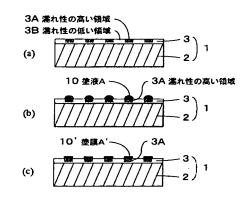
#### (54) 【発明の名称】パターンの形成方法

#### (57)【要約】

【課題】基板の表面にパターンを形成する際に、予定した区画内に均一かつムラ無く、しかもはみ出すことを防止して、塗液を適用でき、適用された種々の物質に基づき、製品の物理的機能が十分に発揮されることを可能にする。

【解決手段】基板2上にエネルギーの付与により濡れ性が変化する濡れ性変化性層3を積層し、パターン露光等により、濡れ性の高い部分3Aを生成させ、極性が高い溶媒で調製した塗液10の乾燥塗膜10、を形成することにより、課題を解決することができた。さらに塗膜10、と親和性を有する溶媒を用いて調製した塗液を用いて、塗膜10、上に別の塗膜を形成することもできる。

【選択図】 図4



大日本印刷株式会社内 Fターム(参考) 2H048 BA02 BA45 BB02 BB08 BB24 BB42 3K007 AB18 DB03 FA01

#### 【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

#### 【請求項2】

#### 【請求項3】

前記濡れ性変化性層に、パターン状にエネルギーを付与する際のエネルギー付与手段が、 光照射、プラズマ処理、もしくは光照射による光触媒反応のいずれかであることを特徴と する請求項1または請求項2記載のパターンの形成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

### 【発明の属する技術分野】

本発明は、パターンの形成方法に関するもので、エネルギーの付与により、濡れ性が変化する層で被覆された表面に、エネルギーをパターン状に付与して、相対的に濡れ性の高い区域からなるパターンを形成し、そのパターンを利用して、塗液を選択的に付着させるパターンの形成方法に関するものである。

#### [0002]

#### 【従来の技術】

所定のパターンを対象物の表面に施すには、通常、印刷法が利用される。印刷法において、インキを対象物にパターン状に施すための方策は、専ら印刷版側で行なわれ、例えば、版の表面の凹凸差や、表面の親水性および/または親油性等の性質の差を利用し、インキを印刷版の表面に選択的に、即ちパターン状に付着させ、その後、紙等の対象物に転移させている。こうして得られる印刷物は、読んだり眺めたりするためのものであるので、印刷物全体のインキの付着ムラがあることは好ましくないが、細部、例えば、個々の網点内におけるインキの付着ムラは、問題にならないことが多い。

#### [0003]

しかしながら、印刷法を利用して、電気回路や、高抵抗のインキ塗膜からなる発熱体等が形成されるようになると、インキの付着ムラは、印刷された各部分の抵抗値等の性質の差達を生じるため、より一層の厳密な印刷が望まれるようになってきている。

#### [0004]

さらに、有機トランプスタ、有機太陽電池、もしくは有機EL素子等の、有機物を用いた有機デバイスが作られるようになり、種々の機能を持つ複数の層を同一対象物に印刷、もしくはされ以外の方法により設けるようになることも行なわれるようになってきている。例えば、液晶ディスプレイ用のカラーフィルターや有機EL素子の製造の際には、種々の

10

20

30

有機物が、ドライプロセスやウェットプロセスによって成膜され、 ウェットプロセスとし ては、スピンコート法や、インクジェット法、印刷法、もしくはディスペンサー法などが 利用されている。

[0005]

ところで、有機デバイスの製造時には、液晶ディスプレイ用のカラーフィルターにおける 異なる色相の材料の塗り分けのように、異なる素材からなる細かいパターンとうしを密集 させて形成する必要があるが、ウェットプロセスを利用する際には、インキや塗液が隣接 するパターン部分に流出する恐れがあるため、凸状の仕切部材をパターンの境界に設ける ことが行なわれ、この仕切部材全体、もしくはその表面を、フッ素系化合物等の 液性の 素材で構成し、インキや塗液をはじく性質を与え、塗液が仕切部材で区画された領域内に のみ適用されるようにしている。

[0006]

しかし、仕切部材の表面が 液性を有しているため、凸状の仕切部材ので温に適宜、れた インキや塗液がはじかれ、仕切部材で区画された領域の周辺部に、イント、宝液が十分に 付着しなり部分が生じる場合がある。従って、液晶デ スプレイニシカラーフィルターの 場合であれば、カラーフィルターの機能が不十分にガー、回嫁の鮮明度やコントラストが 低下する。

[0007]

あるいは、有機EL窯ュニニ、仕切部材で区画された領域内の周辺部に、蛍光体が十分 に与着しない無人が生じると、蛍光体をはさんで設けられた電極間に電圧を印加した際に 、電極と、この短絡が起こり、発光しなりことがある。

20

[0008]

例示したように有機デバイスにおいては、仕切部材が 液性であると、仕切部材の側面で インサや塗液がはじかれるため、仕切部材で区画された領域内に、適用されるべき物質が 不均一に、ムラを有して付着し、結果として、得られる有機デパイスが発揮すべき機能が 十分発揮されないという問題が生しる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明においては、対象物の表面に種々の物質をごく接近させて適用する際に、 予定した区画内に均一かつムラ無く適用することが可能で、しかも、予定した区画外に適 用されることを防止し、適用された種々の物質に基づく、製品の物理的機能が十分に発揮 されることを可能にするパターンの形成方法を提供することを課題とする。

30

[0010]

【課題を解決する手段】

発明者の検討の結果、対象物の表面に、エネルギーの付与により、表面の濡れ性が変化し 得る素材からなる濡れ性変化性層を積層し、この濡れ性変化性層にパターン状にエネルギ ーを付与して、濡れ性の高い部分を生成させ、その部分に極性が高い溶媒で溶解もしくは 分散した物質の塗膜を形成するが、または、形成された塗膜上に、さらに、その塗膜を構 成する物質との親和性を有する溶媒を含む塗液を用いて塗膜を形成することにより、意図 した領域内部に、物質をムラなく適用することが可能であることが判明し、次のような本 発明に到達することができた。

40

[0011]

第1の発明は、基板上に、エネルギーの付与により、表面の濡れ性が変化し得る素材から なる濡れ性変化性層を積層して濡れ性変化性基板を作成し、前記濡れ性変化性基板の前記 濡れ性変化性層に、パターン状にエネルギーを付与して、エネルギーが付与された部分に 、エネルギーが付与されなかった部分にくらべて濡れ性の高りパターン状の部分を生成さ せ、生成した前記濡れ性の高いパターン状の部分に、極性が相対的に高い溶媒Aを少なく ・とも1種類含む溶媒と前記溶媒に溶解もしくは分散する溶質Aとを含有する塗液Aを塗布 し、塗布後、乾燥させて、前記濡れ性の高いパターン状の部分上に前記溶質Aの層を形成 することを特徴とするパターンの形成方法に関するものである。

[0012]

[0013]

第3の発明は、第1または第2の発明において、前記濡れ性変化性層に、パターン状にエネルギーを付与する際のエネルギー付与手段が、光照射、プラズマ処理、もしくは光照射による光触媒反応のいずれかであることを特徴とするパターンの形成方法に関するものである。

[0014]

【発明の実施の形態】

図1~図7は、いずれも、本発明のパターンの形成方法の各工程の概略を示す図であり、図1~図3は、基板上に濡れ性の高いパターン状の部分を生成する過程の代表的な三つの態様を示す図であり、図4 および図5 は、濡れ性の高い部分を利用してパターンを形成する過程の代表的な二つの態様を示す図であり、図6 および図7はパターンを形成する際の異なる態様を示す図である。

[0015]

図1 ( a ) に示すように、第1の基板2の表面にシリコーン等からなる濡れ性変化性層3が積層された濡れ性変化性基板1を準備する。また、この態様においては、図1 ( b ) に示すように、別の第2の基板5に二酸化チタン等からなる光触媒層6が積層された光触媒基板4を準備する。

[0016]

[0017]

次に図4(6)に示すように、濡れ性変化性層3に、極性の高い溶媒Aで溶質Aを、好ましくは溶解した塗液Aを塗布し、濡れ性の高い領域3Aに塗液A(符号:10)を選択的に付着させ、その後、乾燥させることにより、図4(c)に示すように、濡れ性の高いパターン状の部分3A上に塗膜A、(符号:10、)、言い換えれば溶質Aの層を形成して、濡れ性の高いパターン状の部分3A上に溶質Aの層がらなるパターンを形成する。

[0018]

以上の方法によれば、濡れ性の高いパターン状の部分上に、極性の高い溶媒Aに好ましく は溶解し得る溶質Aの層からなるパターンの形成ができるが、形成されるパターンを構成 する素材としては、溶解性の観点から、極性の高いものが適しており、極性が極端に低い 10

20

30

40

素材を用いると、濡れ性の高いパターン状の部分上への選択的なパターンの形成がむずか しいことがある。

[0019]

[0020]

このように、一旦形成した、溶質Aの層(符号:10′)を利用することにより、工程が付加されて、工程数が増加するものの、塗液Bとしては、溶質Aの層がらなるパターンが形成されていない部分との親和性よりも、溶質Aの層(符号:10′)との親和性のある溶媒Bを含むものを用いればよいので、先の溶質Aにおいて、極性の高い溶媒Aに好ましくは溶解し得るものを用いたのにくらべれば、溶媒Bの選択範囲が広がる利点がある。

[0021]

基板上に濡れ性の高いパターン状の部分を生成する過程としては、上記した例以外にも次のような過程を選択することもできる。

[0022]

シリコーン等からなる濡れ性変化性層3が積層された濡れ性変化性基板1は、図1を引用して説明したように光触媒基板4を使用するのではなく、図2に示すように、濡れ性変化性基板1単独に対し、紫外線を照射することによっても、濡れ性変化性層3に濡れ性の高いパターン状の部分を生成することができる。この場合において、パターン化は、光触媒基板4を使用するときと同様、マスク7を介して行なうことができる。

[0023]

あるいは、濡れ性変化性基板1は、図3に示すように、プラズマ雰囲気に曝すことによっても、濡れ性変化性層3に濡れ性の高いパターン状の部分を生成することができる。この場合にあいて、パターン化は、濡れ性変化性層3上に、プラズマ耐性のある素材により、マスクパターン9を直接に設けた後、プラズマ雰囲気に曝すことにより、行なうことができる。あるいは、濡れ性変化性層3上を金属製等のマスクで被覆して行なってもよい。【0024】

基板1は板状、もしくはフィルム状のものであり、されらを構成する素材としては、ガラス、石英等の無機材料、または樹脂板もしくは樹脂フィルム等を挙げることができる。ここでは、「基板」の用語は、フィルム状の物も含む意味で使うので、基材と言い換えてもよい。基板1が樹脂フィルムであれば、得られる製品を、丸めたり曲げたりすることが可能なフレキシブルなものとすることができる。

[0025]

 . .

10

20

30

40

20

30

40

50

フェニレンスルフィド、液晶性ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリオキシメチレン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリアクリレート、アクリロニトリルースチレン樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン、シリコーン樹脂、非晶質ポリオレフィン等が挙げられるが、この他でも条件を満たす高分子材料であれば使用可能であり、また上記した樹脂の出発原料であるそノマーを2種類以上用いて共重合させて得られる共重合体であっても良い。

[0026]

なお、 基板 1 は、 本発明のパターンの形成方法により得られる製品が種々の機能を果たすものである場合には、 基板 1 単独ではなく、 基板 1 上の、この次に説明する濡れ性変化性層 3 との間に、種々の層が積層されたものであり得る。

[0027]

基板1は、本発明におけるパターンの形成の対象物である。後述するように、本発明のパターンの形成方法は、有機EL素子の蛍光層のパターンの形成に適用すると非常に好ましいが、蛍光層のパターンの形成の際の対象物は、例えば、ガラス基板に透明電極層単独、もしくは更にその他の層を伴なったものである。

[0028]

濡れ性変化性層 3 は、エネルギーの付与により、表面の濡れ性が変化し得る素材からなるもので、具体的には、オルガノポリシロキサン等のケイ素化合物であって、濡れ性の高いパターン状の部分を生成する際のエネルギーの付与により、分解されない高い結合エネルギーを有するものがよい。例えば、(1)ソルケル反応等によりクロロまたはアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して得られる大きな強度を発揮するオルガノポリシロキサン、あるいは(2) 水性や 油性に優れた反応性シリコーンを架橋したオルガノポリシロキサン等を挙げることができる。

[0029]

前記(1)の場合、一般式 $Y_n$  Si $X_{4-n}$  (Yの添え字n およびXの添え字4-n におけるnは1~8の整数である。)で表されるケイ素化合物の1種または2種以上のn水分解縮合物、もしくは共加水分解化合物が主体である。また、一般式 $Y_n$  Si $X_{4-n}$  において、Yは、例えばアルキル基、フルオロアルキル基、ピニル基、アミノ基またはエポキシ基であり、Xは、例えばハロゲン、メトキシル基、エトキシル基、またはアセチル基である。

[0030]

一般式 Y n SiX4- n に該当するものとしては、メチルトリクロルシラン、メチルトリ プロムシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリイソ プロポキシシラン、メチルトリセープトキシシラン、エチルトリクロルシラン、エチルト リプロムシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイ ソプロポキシシラン、エチルトリモープトキシシラン、n-プロピルトリクロルシラン、 n - プロピルトリプロムシラン、n - プロピルトリメトキシシラン、n - プロピルトリエ トキシシラン、n-プロピルトリイソプロポキシシラン、n-プロピルトリt-プトキシ シラン、n-ヘキシルトリクロルシラン、n-ヘキシルトリプロムシラン、n-ヘキシル トリメトキシシラン、n-ヘキシルトリエトキシシラン、n-ヘキシルトリイソプロポキ シシラン、n - へキシルトリt-プトキシシラン、n - デシルトリクロルシラン、n - デ シルトリプロムシラン、n-テシルトリメトキシシラン、n-デシルトリエトキシシラン 、n-デシルトリイソプロポキシシラン、n-デシルトリt-プトキシシラン、n-オク タデシルトリクロルシラン、n - オクタデシルトリプロムシラン、n - オクタデシルトリ メトキシシラン、n-オクタテシルトリエトキシシラン、n-オクタテシルトリイソプロ ポキシシラン、n - オクタデシルトリt - プトキシシラン、フェニルトリクロルシラン、 フェニルトリプロムシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン 、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェニルトリセープトキシシラン、テトラクロル シラン、テトラプロムシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプ

トキシシラン、プメトキシプエトキシシラン、プメチルプクロルシラン、プメチルププロ ムシラン、プメチルプメトキシシラン、プメチルプエトキシシラン、プフェニルジクロル シラン、 プフェニルププロムシラン、 プフェニルプメトキシシラン、 プフェニル プエトキ シシラン、フェニルメチルジクロルシラン、フェニルメチルジブロムシラン、フェニルメ チルプメトキシシラン、フェニルメチルプエトキシシラン、トリクロルヒドロシラン、ト リプロムとドロシラン、トリメトキシとドロシラン、トリエトキシとドロシラン、トリイ ソプロポキシヒドロシラン、トリセープトキシヒドロシラン、ビニルトリクロルシラン、 ピニルトリプロムシラン、ピニルトリメトキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、ピニ ルトリイソプロポキシシラン、ピニルトリセーブトキシシラン、トリフルオロプロピルト リクロルシラン、トリフルオロプロピルトリプロムシラン、トリフルオロプロピルトリメ 10 トキシシラン、トリフルオロプロピルトリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイ ソプロポキシシラン、トリフルオロプロピルトリセープトキシシラン、γーグ リシドキシ プロピルメチルジメトキシシラン、Y-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 Υ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、Υ-グリシドキシプロピルトリエトキシ シラン、 Y-グリシドキシプロピルトリイソプロポキシシラン、 Y-グリシドキシプロピ ルトリtープトキシシラン、γーメタアクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ ーメタアクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、Y-メタアクリロキシプロピルト リメトキシシラン、 γ - メタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン、 γ - メタアクリ ロキシプロピルトリイソプロポキシシラン、アーメタアクリロキシプロピルトリモープト キシシラン、Υ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Υ-アミノプロピルメチルジ 20 エトキシシラン、アーアミノプロピルトリメトキシシラン、アーアミノプロピルトリエト キシシラン、 アーアミノプロピルトリイソプロポキシシラン、 アーアミノプロピルトリモ ープトキシシラン、Y-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、Y-メルカプトプ ロピルメチルプエトキシシラン、γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ-メル カプトプロピルトリエトキシシラン、Y-メルカプトプロピルトリイソプロポキシシラン 、γーメルカプトプロピルトリセープトキシシラン、βー(3、4ーエポキシシクロヘキ シル) エチルトリメトキシシラン、もしくはB- (3.4-エポキシシクロヘキシル) エ チルトリエトキシシラン、または、以上のものの各々の部分加水分解物を挙げることがで き、あるいはこれらの任意の組合せによる混合物を挙げることができる。 [0031]30 また、フッ素を有するケイ素化合物は、塗液を調製して塗布する際の塗布適性が優れ、自 身は 液性でありながら、濡れ性変化性層を構成してエネルギーを付与した際に、濡れ性 の変化が大きいので、好ましいものであり、特に、フルオロアルキル基を含有するポリシ ロキサンを用いることが好ましい。フルオロアルキル基を含有するポリシロキサンとして は、具体的には、次段落に示すフルオロアルキルシランの1種または2種以上の加水分解 縮合物、共加水分解縮合物が学げられ、また、一般にフッ素系シランカップリング剤とし て知られているものを使用してもよい。 [0032]  $CF_3$  ( $CF_2$ )  $_3$   $CH_2$   $CH_2$  Si ( $OCH_3$ )  $_3$  ; CF3 (CF2) 5 CH2 CH2 Si (OCH3) 3: 40 CF<sub>3</sub> (CF<sub>2</sub>)<sub>7</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> Si (OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>: CF3 (CF2), CH2 CH2 Si (OCH3);  $(CF_3)_2CF(CF_2)_4CH_2CH_2Si(OCH_3)_3$ : (CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub> CF (CF<sub>2</sub>)<sub>6</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> Si (OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>: (CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CF(CF<sub>2</sub>)<sub>8</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>; CF3 (C8 H4) C2 H4 Si (OCH3) 3; CF3 (CF2)3 (C6 H4) C2 H4 Si (OCH3)3:  $CF_3$  ( $CF_2$ ) 5 ( $C_6H_4$ )  $C_2H_4$  Si ( $OCH_3$ ) 3: CF<sub>3</sub> (CF<sub>2</sub>)<sub>7</sub> (C<sub>6</sub> H<sub>4</sub>) C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> Si (OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>: CF<sub>3</sub> (CF<sub>2</sub>)<sub>3</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> SiCH<sub>3</sub> (OCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>: 50

```
CF_3 (CF_2) _5 CH_2 CH_2 SiCH_3 (OCH_3) _2 :
CF3 (CF2) 7 CH2 CH2 SiCH3 (OCH3) 2:
CF3 (CF2), CH2 CH2 SiCH3 (OCH3)2:
(CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CF(CF<sub>2</sub>)<sub>4</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>SiCH<sub>3</sub>(OCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>:
(CF_3) _2 CF (CF_2) _6 CH_2 CH_2 SiCH_3 (OCH_3) _2 :
(CF_3)_2CF(CF_2)_8CH_2CH_2SiCH_3(OCH_3)_2:
CF<sub>3</sub> (C<sub>6</sub> H<sub>4</sub>) C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> SiCH<sub>3</sub> (OCH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>:
CF_3 (CF_2) _3 (C_6H_4) C_2H_4 S i CH_3 (OCH_3) _2 :
CF_{3} (CF_{2}) _{5} (C_{6} H_{4}) C_{2} H_{4} SiCH_{3} (OCH_{3}) _{2} :
CF_{3} (CF_{2}) _{7} (C_{6}H_{4}) C_{2}H_{4} S i CH_{3} (OCH_{3}) _{2} :
                                                                           10
CF_3 (CF_2) _3 CH_2 CH_2 Si (OCH_2 CH_3) _3 :
CF3 (CF2) 5 CH2 CH2 Si (OCH2 CH3) 3:
CF3 (CF2) 7 CH2 CH2 Si (OCH2 CH3) 3:
CF3 (CF2), CH2 CH2 Si (OCH2 CH3) 3 : および
CF3 (CF2) 7 802 N (C2 H5) C2 H4 CH2 8 i (OCH3) 3.
[0033]
また、前記(2)の 水性や 油性に優れた反応性シリコーンを架橋したオルガノポリシ
ロキサンは、一般式一(S i(R^1)(R^2) O)_n ーで表される骨格を有する化合物か
```

[0034]

また、前記のオルガノポリシロキサンとともにジメチルポリシロキサンのような架橋反応 を起こさない安定なオルガノシリコン化合物をパインダーに混合してもよい。

[0035]

上記のケイ繁化合物は、必要に応じて、界面活性剤もしくはその他の添加剤と共に水もしくは溶剤を用いて溶解ないし分散させ、基板1上に公知の方法によって塗布し、加熱等でより乾燥させることにより、濡れ性変化化性層3を形成して、濡れ性変化性基板11を表では、スピンコート法、インクジェット法、キャストとは、日路、ディスペンサー法、マイクログラピアコート法、グラピアコート法、パーコート法、トロールコート法、フイヤーパーコート法、ディップコート法、フレキソ印刷、オーセット印刷、もしくはスクリーン印刷のいずれの方法によってもよい。濡れ性変化性層3の厚みは、0.001μm~0.01μm~ある。

[0036]

図1を引用して説明した、濡れ性の高いパターン状の部分を生成する過程においては、濡れ性変化性基板1とは別に光触媒基板4を用いる。光触媒基板4は、濡れ性変化性基板1の基板2とは別の基板5上に光触媒層6が積層されて形成されたものである。基板5は、原則的に、濡れ性変化性基板1の基板2と同様の素材を用いて構成することができるが、光触媒基板4側から露光する場合には、基板5が露光光に対して透明性を有するものであることが好ましい。また、光触媒層6形成の際に焼成を伴なうときは、基板5は、無機材料で構成されていることが好ましい。

[0037]

光触媒層 6 は、濡れ性変化性層 3 と接触した状態、もしくは極く接近した作用距離にある状態で光照射を受けることにより、濡れ性変化性層 3 の濡れ性の変化をもたらす、いわゆる光触媒反応を起こす光触媒を含有するものである。光触媒反応の機構は必ずしも明らか

20

30

40

20

40

50

ではないが、光の照射によって光触媒に生成したキャリアが、ケイ素化合物の化学構造を直接変化させ、あるいは酸素、水の存在下で生じた活性酸素種によって前記ケイ素化合物の化学構造を変化させるものと考えられ、フルオロアルキル基を有する等のフッ素を有するケイ素化合物においては、フッ素化合物が脱離し、水酸基に置換するものと考えられる

[0038]

光触媒は、光照射の際に、上述した濡れ性変化性層3の表面の濡れ性を変化させ得るものであればどのようなものでもよりが、光半導体として知られる、例えば二酸化チタン(TiO2)、酸化亞鉛(区nO)、酸化スズ(SnO2)、チタン酸ストロンチウム(SPTiO3)、酸化タングステン(WO3)、酸化ピスマス(Bi2O3)、および酸化鉄(Fe2O3)のような金属酸化物を挙げることができ、これらから選択して1種または2種以上を混合して用いることができる。

[0039]

光触媒としては、特に二酸化チタンが、パンドギャップエネルギーが高く、化学的に安定で毒性もなく、入手も容易であることから好適に使用される。二酸化チタンには、アナターセ型とルチル型があり本発明ではいずれも使用することができるが、アナターセ型の二酸化チタンが好ましい。アナターセ型二酸化チタンは励起波長が380mm以下にある。

このようなアナターゼ型二酸化チタンとしては、例えば、塩酸解 型のアナターゼ型チタニアソル(石原産業(株)製STS-02(平均粒径7nm)、もしくは石原産業(株)製ST-K01)、硝酸解 型のアナターゼ型チタニアソル(日産化学(株)製TA-15(平均粒径12nm))等を挙げることができる。

[0041]

基板5上に光触媒層6を形成するには、二酸化チタンの場合であれば、四塩化チタン等のチタンの無機塩、もしくはテトラエトキシチタン等の有機チタン化合物を基板5上で加水分解および脱水縮合し、次いで、焼成することによって得ることができ、あるいは、濡れ性変化性層3を形成し得るものとして挙げたオルガノポリシロキサンをバインダとして用いて、光触媒あよびパイングの分散液を調製して、塗布し、加水分解および脱水縮合することにより、行なうことができ、パインダとしては、無定形シリカを用いることもできる。いずれも、塗布の際には、濡れ性変化性層3を形成する際の塗布の方法を利用することができる。

[0042]

図1 (c)を引用して説明したように、濡れ性変化性基板1と光触媒基板4とは、各々の濡れ性変化性層3と光触媒層6とが向かい合うようにして重ね、マスクワを介して光を照射することにより、パターン状露光を行う。マスクワは、光触媒基板4側もしくは濡れ性変化性基板1側に配置することができる。

[0043]

露光に使用する光は、光触媒を励起することができるものであれば、限定されることはなく、紫外線、可視光線、赤外線、またはこれらの光線よりもさらに短波長もしくは長波長の電磁波、放射線であり得る。光触媒として、アナターセ型チタニアを用いる場合は、励起波長が先に述べたように380mm以下にあるので、光触媒の励起は紫外線により行うことができ、水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプ、エキシマレーザー、もしくはその他の紫外線光源を使用することができる。

[0044]

なお、以上の説明では、マスク7として、濡れ性変化性基板1および光触媒基板4とは別のものを使用したが、マスク7のマスクパターン9を、濡れ性変化性基板1もしくは光触媒基板4の基板2(もしくは5)の露出面側に設け、マスクパターン9側から光照射することによっても、パターン状露光を行うことができる。

[0045]

濡れ性変化性層3の濡れ性を変化させて濡れ性の高いパターン状の部分を生成させるため

のエネルギー付与の手段としては、上記の光触媒を用いた光照射以外にも、光触媒を用いない光照射、もしくはプラズマ処理があり得る。

[0046]

光触媒を用いない光照射は、図2に示すように、濡れ性変化性基板1の濡れ性変化性層3側からマスク7を介して行なうことができ、使用するマスク7あよび光は、光触媒を用いた光照射の際と同じである。なお、光照射は、濡れ性変化性基板1の基板2側に配置したマスク7を介して行なうこともできるし、基板2の濡れ性変化性層3を有しない側にマスクパターン9を直接設け、そのマスクパターン9を介して行なうこともできる。

[0047]

プラスマ処理は、ガスプラスマを用いたドライエッチング装置を用いて行なうことができる。使用ガスは、フッ素化合物を除去できるものであれば、特に限定されることはないが、O2、CH4、もしくはCF4が好ましい。また、使用ガスは、2種類以上を混合したものであってもよい。

[0048]

プラズマ処理により、濡れ性の高いバターン状の部分を生成させるためには、濡れ性変化性層3の表面に、適宜な素材によるマスクバターンを設けることにより、マスクで覆われていない露出部分をプラズマ処理させればよく、バターン化する際に便利なことから、適宜な感光性樹脂、例えば、レジスト形成用の感光性樹脂を用いて形成するとよい。あるいは、濡れ性変化性層3上を金属製等のマスクで被覆して行なってもよい。

[0049]

光触媒を用いた光照射、光触媒を用いない光照射、もしくはプラズマ処理のいずれのエネルギーの付与の手段によるにせよ、濡れ性変化性基板1の濡れ性変化性層3の表面には、エネルギーが付与された部分に、エネルギーが付与されなかった部分にくらべて濡れ性の高いパターン状の部分にパターンの形成を行なうことが可能になる。このようなパターンの形成に用いるのに適した塗液は、好ましくは、極性が相対的に高い溶媒Aに、溶媒Aに溶解もしくは分散する溶質Aを溶解した溶液Aである。

[0050]

ここで、極性が相対的に高い溶媒Aとは、25℃における誘電率(ε)が20以上であるものが好ましく、そのような溶媒Aの具体例としては、極性の高い溶媒である、水(誘電率:78.3、この段落における以降の( )内の数値は誘電率を示す。)、メタノール(32.6)、エタノール(24.6)、N.N-ジメチルホルムアミド(37.0)、N.N-ジメチルアセトアミド(37.8)、ジメチルスルホキシド(46.6)、N-メチルピロリドン、もしくはヘキサメチルホスホルアミド(34.0)などを学げることができる。中でも、極性が非常に高い、水、メタノール、もしくはエタノールを用いることがより好ましい。

[0051]

以上の溶媒Aの中から、溶質Aの溶解性もしくは分散性、塗液の粘度、固形分濃度、表面張力、沸点、融点、基板1の表面との接触角、および乾燥性を考慮して選択し、使用することができる。なお、溶媒Aとしては、上記のうちから2種類以上を選択して、混合して用いることもできる。

[0052]

また、溶質Aとしては、上記の極性の高い溶媒Aに溶解し得るポリピニルアルコール、ポリアニリン、ポリチオフェン誘導体、ポリスチレンスルホネート、ポリエチレングリコール、もしくはポリプロピレングリコール等の樹脂を用いることができる。

[0053]

溶質 A は、上記の極性の高い溶媒 A に対する溶解度が必ずしも高くはないが、上記の極性の高い溶媒 A に分散し得るものであってもよく、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルエーテル、フタロシアニン誘導体、もしくは金属錯体を挙げることができる。

[0054]

20

10

30

20

40

50

上記のような溶媒Aに溶解もしくは分散する溶質Aを用いて塗液Aを調製する。溶媒Aおよび溶質Aの素材にもよるが、塗液A中の溶質Aの割合は、0.1~20%(質量基準)程度である。濡れ性変化性層3の表面の、濡れ性の高いパターン状の部分に塗布し、塗布後、乾燥させることによって、濡れ性の高いパターン状の部分に上記の溶質Aの層を形成することができる。なお、塗液Aを調整する際の溶媒Aは、先に述べたように、1種類のみからではなく、2種類以上からなっていてもよい。さらに、溶媒Aは、極性が相対的に高くはない溶媒、もしくは極性が低い溶媒と併用することもできる。

[0055]

やや特殊ではあるが、有機EL素子を構成するための正孔注入パッファー形成用組成物、例えばポリ(3、4)エチレンジオキシチオフェン/ポリスチレンスルホネート(略称PEDOT/PSS、パイエル社製、商品名:B瓜メセトONP AI 4083、水溶液として市販。)も、極性が高い溶媒である水と、水に溶解する溶質とを含有する塗液として使用することができる。

[0056]

[0057]

濡れ性の高いパターン状の部分のみに選択的な塗布を行なう、より好ましい方法としては、インクジェット法や、加圧された塗液溜め(タンク)および電磁弁等と組み合われて、塗液の吐出を制御されたシリンジ(注射筒)を用いるシリンジ法(もしくはディスのサ法)等があり、これらの方法によると、濡れ性の高いパターン状の部分の、個々のの環れ性が高いために、塗液Aがひるがって、濡れ性の高いパターン状の部分を塗液でき、塗液Aが極端に過剰につる、流れ性の高いパターン状の部分の外まで塗液Aがひるがることができる。 で、意図した通り、濡れ性の高いパターン状の部分のみに塗液Aを適用することができる。なお塗液の圧送を、チュープボンプを用いて行なうこともできる。

[0058]

適用された塗液Aは、適宜な手段、すなわち、自然放置、加熱を伴なわなり風乾、加熱を 伴なう風乾、もしくは赤外線ランプ等による赤外線照射により乾燥させ、濡れ性変化性層 3の濡れ性の高いパターン状の部分に、溶質Aの層が良好に形成される。

[0059]

ここで形成される溶質Aの層は、溶質Aが、極性が相対的に高い溶媒Aに溶解もしくは分散する性質を持つものである必要があるので、上記の方法のみでは、濡れ性の高いパターン状の部分に形成ができない素材もあり得る。このような場合でも、濡れにの高いパターン状の部分に形成した溶質Aの層を利用して、必ずしも、極性が相対的に高い溶媒Aに溶解もしくは分散する性質を持たない溶質Bの層を形成するためには、ならの親和性を有する溶媒Bを用いて溶解もしくは分散する溶質Bを、溶質Aの層上に塗布することにより、濡れ性の高いパターン状の部分に溶質Aの層を介して、溶質Bの層を形成することができる。

[0060]

溶質Aと親和性を有する溶媒Bとしては、極性が相対的に高い溶媒Aの具体例として挙げたもの以外の、これら溶媒Aにくらべて極性の低い溶媒を用いることができ、以下に挙げ

るような溶媒の中から、溶質 B の溶解性もしくは分散性、塗液の粘度、固形分濃度、表面張力、沸点、融点、溶質 A の層の表面との接触角、および乾燥性を考慮して選択し、使用することができる。ここで、溶質 A と親和性のある溶媒 B として、先に学げた溶媒 A よりも極性の低い溶媒を選ぶのは、塗液 B の塗布時に溶質 A に影響を与えないためと、溶質 A を構成する素材の分子中に溶媒 B との親和性を有する、例えば炭素鎖部分等が存在するからである。

[0061]

[0062]

溶質Bとしては、溶媒Bが極性の高いものでなくてもよいので、一般的な溶媒に可溶な樹脂が使用でき、実際に使用した溶媒Aにもよるが、水溶性や水分散性以外の樹脂を選択することが好ましい。また、樹脂に加えて、染料もしくは顔料等の着色剤を配合して、着色層を形成することもできる。

[0063]

溶質Bとしては、樹脂以外であってもよく、溶媒Bに溶解もしくは分散し得る様々なものを使用することができる。前段落で学けた染料もしくは顔料等の着色剤を、樹脂を併用することなく使用することができる。溶質Bの具体例は以降に挙げるが、溶媒Bと溶質Bを用いて塗液Bを調製し、塗液Aを塗布したのと同様な方法により、濡れ性の高いパターン状の部分上の溶質Aの層上に塗布し、塗布後、乾燥させることによって、溶質Bの層を形成することができる。

[0064]

溶質 B の好ましい例は、 有機デバイス、 例えば、 有機 E L 素子の各層を構成する ための 素材、 とりわけ、 有機 E L 素子の E L 層を構成する 素材、 中でも 発光層を構成する 素材である。 せこで、 有機 E L 素子について説明すると、 有機 E L 素子は、 原理的には、 基板、 第1 電極、 E L 層、 および 第2 電極と から構成されている。 基板 1 と 第1 電極との間には 他の層が介在してもよい。

[0065]

Eし層は、有機Eし素子のタイプにもよるが、発光層単独、もしくは設けることが可能な他の任意の層と発光層との組合せにより構成される。任意の層としては、発光層に正孔を輸送する正孔輸送層、および発光層に電子を輸送する電子輸送層に正孔を注入する正孔輸送層と呼ぶことがある)、ならびに、発光層または正孔輸送層に正孔を注入する正孔を注入層、および発光層または電子輸送層に電子を注入する電子注入層(これらはまとめて、電荷注入層と呼ぶことがある)がある。また、これらの各層のほか、絶縁層、隔壁層、および第2電極層上の封止材等がある。

[0066]

有機 E L 素子における基板は、本発明のパターンの形成方法における基板 1 と同じ素材で構成することができる。基板は透明であってもよいが不透明であってもよい。また、封止

10

20

30

材は、基板1と同様な素材で構成するか、もしくはガスパリア性樹脂等の樹脂を用いて構 成された塗料の塗膜であってより。

[0067]

第1電極および第2電極は、基板上に積層する方を第1電極、EL層上に積層する方を第 2電極と呼ぶ。第1電極および第2電極は、基板に対して全面に形成されていても、もし くはパターン状に形成されていてもよい。第1電極および第2電極は、いずれかが陽極、 他方が陰極であることが好ましく、また、いずれか一方が、透明または半透明であり、陽 極としては、正孔が注入し易いように仕事関数の大きり導電性材料で構成されていること が好ましく、陰極としては、電子が注入し易りように仕事関数の小さり導電性材料で構成 されていることが好ましい。いずれの電極も、抵抗はできるだけ小さいものが好ましく、 一般には、金属材料が用いられるが、有機物あるりは無機化合物を用いてもよい。

[0068]

第 1 電極および 第 2 電極を構成し 得 3 具体的な陽極材料としては、 酸化インジ ウム 錫( I TO)、酸化インプウム、金、もしくはポリアニリン等を、また、具体的な陰極材料とし ては、マグネシウム合金(MタAタ他)、アルミニウム合金(AILi、AICの、AI M3他)、もしくは金属カルシウムを挙げることができる。陽極材料および陰極材料とも 、複数の材料の混合されたものであってもより。させてもより。 [0069]

発光層を構成する素材としては、大別して、色素系、金属錯体系、もしくは高分子系のも のがある。

20

10

[0070]

色素系としては、シクロペンタジエン誘導体、テトラフェニルプタジエン誘導体、トリフ ェニルアミン誘導体、オキサジアソール誘導体、ピラソロキノリン誘導体、ジスチリルベ ンセン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、シロール誘導体、チオフェン環化合物、ビ リジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘導体、トリファ ニルアミン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマーがある。

[0071]

金属錯体系としては、アルミキノリノール錯体、ペンツキノリノールペリリウム錯体、ペ ンソオキサゾール亞鉛錯体、ペンソチアソール亞鉛錯体、アソメチル亞鉛錯体、ポルフィ リン亞鉛錯体、もしくはユーロピウム錯体等の、中心金属にAI、区内、もしくはBe等 または、Tb、Eu、もしくはDメ等の希土類金属を有し、配位子にオキサジアゾール、 チアプアソール、フェニルピリプン、フェニルペンツィミダゾール、キノリン構造等を有 する金属錯体がある。

30

[0072]

高分子系としては、ポリパラフェニレンピニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリパ ラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリピニルカルパソー ル等、もしくはポリフルオレン誘導体がある。

[0073]

発光層を構成する素材には、ドーピング材料を配合してもよく、ドーピング材料としては 、ペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルプレン誘導体、キナクリドン誘導体、スクアリウ ム誘導体、ポルフィリン誘導体、スチリル系色素、テトラセン誘導体、ピラグリン誘導体 、テカシクレン、もしくはフェノキサソンがある。

40

[0074]

正孔注入層(もしくは陽極パッファー材料)を構成する素材としては、フェニルアミン系 、スターパースト型アミン系、フタロシアニン系、酸化パナジウム、酸化モリプデン、酸 化ルテニウム、酸化アルミニウム等の酸化物、アモルファスカーボン、ポリアニリン、も しくはポリチオフェン誘導体がある。

[0075]

電子注入層(もしくは陰極パッファー材料)を構成する素材としては、アルミリチウム合 金、フッ化リチウム、ストロンチウム、酸化マグネシウム、フッ化マグネシウム、フッ化

ストロンチウム、フッ化カルシウム、フッ化パリウム、酸化アルミニウム、酸 化ストロン チウム、カルシウム、ポリメチルメタクリレート、もしくはポリスチレンスルホン酸ナト リウムがある。

[0076]

絶縁層は、絶縁層が設けられた部分において、電極からEL層への電荷の供給を止め、EL層を発光させないために設けられるもので、絶縁層を構成する案材としては、感光性ポリイミド樹脂、もしくはアクリル系樹脂のほか、光硬化型樹脂、もしくは熱硬化型樹脂等の硬化型樹脂、または無機材料などが挙げられる。

[0077]

異なる色を発光するEし層とうしを組み合わせる際には、それらのEし層とうしの間に隔壁を設けることもできる。隔壁を構成する素材としては、感光性ポリイミド樹脂、もしくはアクリル系樹脂のほか、光硬化型樹脂、もしくは熱硬化型樹脂等の硬化型樹脂、または液性樹脂などが挙げられる。

[0078]

以上のような有機EL素子は、本発明のパターンの形成方法を用い、例えば、次のようにして製造される。

[0079]

まず、ITOからなるパターン状の電極をかラス等の基板上に形成して第1電極とする。次に、第1電極が形成された上の全面に、フッ素を含有するポリシロキサンを塗布し、加水分解、重縮合反応を起こさせて、薄膜層を形成する。

[0080]

次に、薄膜層の表面を、パターンマスクを用いて露光し、露光部の濡れ性を高めて親水化させ、親水化した部分に水溶性樹脂の水溶液(例えば、正孔注入パッファー形成用組成物であり得る。)をシリンプ法により塗布し、乾燥させて、水溶性樹脂のパターンを形成する。ここまでの工程により、親水化した部分の上に、水溶性樹脂の層がらなるパターンが形成される。

[0081]

次に、発光層を構成するための素材を、極性の比較的低い溶剤で溶解したものを、やはりシリンジ法により、水溶性樹脂の層のパターンのパターン部分に塗布し、乾燥させて、水溶性樹脂の層上に、発光層のパターンを形成する。

[0082]

発光層のパターンが形成された後、発光層上の表示すべき領域上を覆って金属電極を形成し、続いて、金属電極上を含む全面に防湿のためのポスパリア性樹脂からなる封止材塗料を塗布して、有機EL素子とする。

[0083]

有機EL素子の製造に際しては、基板2上に断面形状が凸状の絶縁層3が形成された間に、上記した発光層を形成することがある。このような場合には、凸状の絶縁層3が形成された基板2上に、濡れ性変化性層3を形成するので、濡れ性変化性層3の表面に、下層の絶縁層3の有無に従った凹凸が生じている。発光層の形成は、絶縁層3が無い部分に発えるのであるが、濡れ性変化性層3へのエネルギーの付与を、絶縁層5か無い部分に力が、凹部の底に行なうのであるが、濡れ性変化性層3へのエネルギーの付与を、絶縁層5かまりはかりであるが、これである。)を含めて濡れ性の高い領域3Aを形成するではより、EL層を形成する塗膜A′(符号:10′)が、所定の区域内に付着する確実性が増す。

[0084]

なお、本発明において、先に形成した溶質Aの層上に溶質Bの層を形成する際には、各層が単純に積層するように説明し、また、図5においても同じ大きさの層が二層積層されたかのように描いたが、基板2の性質や、塗膜A'(符号:10')の厚み、性質、塗液Bの性状等によって、例えば、図7(α)もしくは図7(b)に示すように、塗液B(符号:11)が塗膜A'の左右および上を覆い、塗液Bと基板2との濡れ性の関係により、臨

10

20

30

界角の異なる形状となる。

[0085]

[0086]

【実施例】

(実施例1)

酸化インジウム 錫の透明電極パターンが積層されたガラス基板を準備し、透明電極パターンが積層された側に、テトラメトキシシラン(GE東芝シリコーン(株)製、品名:TSL8114)59、フルオロアルキルシラン(GE東芝シリコーン(株)製、品名:TSL8223)1.59、および0.005NのHCI(水溶液)2.369からなる溶液を20℃の温度で24時間 して得られた溶液を、イソプロピルアルコールで100倍(質量基準、比較例においても同様)に希釈した希釈液をスピンコート法により塗布し、150℃の温度で10分間加熱して乾燥させた後、加水分解、重縮合反応を進行させて透明な薄膜層を形成した。

[0087]

薄膜層上に、Ti〇2 からなる触媒層を表面に有するパターンマスクを、触媒層が薄膜層側になるようにして重ね、パターンマスクの背面側より紫外線を照射した。この紫外線の照射により、露光部の薄膜層中のフッ素が脱離し、水酸基に置換され、露光部が親液性となり、未露光部はフッ素を有することによる 液性が保持されて、親液性区域と 液性区域とからなるパターンが形成された。

[0088]

形成された親液性区域と 液性区域とからなるパターン上に、有機EL用正孔注入パッファー形成用組成物である、ポリ(3、4)エチレンジオキシチオフェン/ポリスチレンスルホネート(パイエル社製、商品名:Bのメナヤのn P

AI 4083、水溶液として市販。)をマイクロシリンジを用いたシリンジ法にて塗布したところ、親液性区域にのみ、有機EL用正孔注入パッファー形成用組成物の5mm×5mmの正方形状の塗膜が形成された。

[0089]

有機EL用正孔注入パッファー形成用組成物の塗布後、加熱して、塗膜を乾燥させた後、クマリン誘導体およびポリピニルカルパソールをキシレンに、固形分が 1 % (質量基準)になるよう溶解した発光層形成用組成物をマイクロシリンジを用いたシリンジ法により塗布したところ、親液性区域上の有機EL用正孔注入パッファー形成用組成物の塗膜の輪郭内いっぱいに発光層形成用組成物が広がり、5 mm×5 mmの正方形状のパターン通りに、塗布ムラが無い均一な発光層が成膜された。

[0090]

(比較例)

有機EL用正孔注入バッファー形成用組成物の塗布を行わず、親液性区域と 液性区域とからなるパターン上に直接、発光層形成用組成物を塗布した以外は、実施例におけるのと

IU

20

30

•

40

同様に行ったが、発光層形成用組成物の塗布ムラが生じ、均一な発光層が得られなかった

#### [0091]

#### 【発明の効果】

請求項1の発明によれば、表面に生成した濡れ性の高いパターン状の部分に、極性が相対的に高い溶媒とその溶媒に溶解もしくは分散する溶質とを含有する塗液を塗布して、溶質のパターンを形成するので、予定した区画外に塗膜が適用されることが無く、しかも、予定した区画内に均一かつムラ無く塗膜が適用されるパターンの形成方法を提供することができる。

#### [0092]

請求項2の発明によれば、請求項1の発明の方法により形成された溶質の塗膜上に、その溶質と親和性を有する溶媒を含む塗液により塗膜を形成するので、後に形成される方の塗膜の溶質としては、極性が相対的に高いものに溶解もしくは分散する有するものに限定されず、使用できる溶質の範囲の広いパターンの形成方法を提供することができる。

[0093]

請求項3の発明によれば、請求項1または請求項2の発明の効果に加え、より具体化されたエネルギー付与手段により、濡れ性の高いパターン状の部分を効率的に形成することが可能なパターンの形成方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

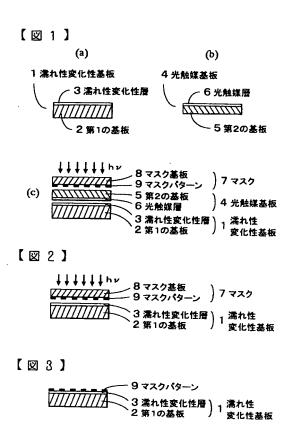
- 【図1】濡れ性変化性基板を光触媒基板を伴なって光照射する様子を示す図である。
- 【図2】濡れ性変化性基板を光照射する様子を示す図である。
- 【図3】濡れ性変化性基板をプラズマ処理する様子を示す図である。
- 【図4】塗膜Aを形成する過程を示す図である。
- 【図5】塗膜Bを塗膜A上に形成する過程を示す図である。
- 【図6】基板が絶縁層を伴なう場合に、塗膜Aを形成する過程を示す図である。
- 【図7】塗膜Bを塗膜A上に形成する際の塗液Bの状態を示す図である。

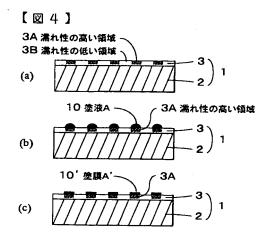
#### 【符号の説明】

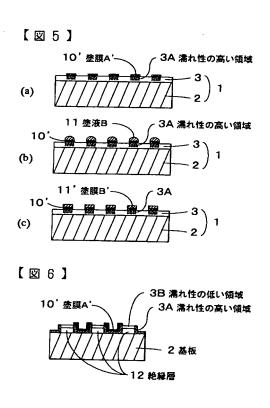
- 1 濡れ性変化性基板
- 2 第1の基板
- 3 濡れ性変化性層
- 4 光触媒基板
- 5 第2の基板
- 6 光触媒層
- 7 マスク(8:マスク基板、9:マスクパターン)
- 10 塗液A(10';塗膜A')
- 12 絶縁層

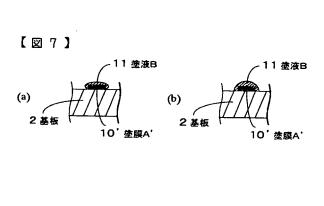
10

20









フロントページの続き

(51) Int. CI. 7

FΙ

テーマコード (参考)

B 0 5 D 5/00 G 0 2 B 5/20

B 0 5 D 3/10 B 0 5 D 5/00

Z

Α

H 0 5 B 33/14

G02B 5/20 101

H 0 5 B 33/14

Fターム(参考) 4D075 AE17 BB41% BB49% BB68% CA36 CA37 CA48 DA04 DA06 DB13

DB36 DB37 DB38 DB39 DB43 DB46 DB47 DB48 DB50 DB52

DB53 DB54 DC18 DC24 EA05 EB43

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.